



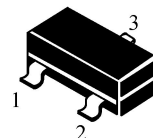
桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM1015(銷售型號 S1015)

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

PNP General Purpose Transistor

■MAXIMUM RATINGS (T_A=25°C) 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V _{CBO}	-50	Vdc
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V _{CEO}	-50	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V _{EBO}	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I _c	-150	mAdc
Base Current 基極電流	I _B	-30	mAdc
Collector Power Dissipation 集電耗散功率	P _C	225	mW
Junction Temperature 結溫	T _j	150	°C
Storage Temperature 儲存溫度	T _{stg}	-55~150	°C

■DEVICE MARKING 打標

GM1015(銷售型號 S1015)=BA



GM1015(銷售型號 S1015)

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	TYP 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-50\text{V},$ $I_E=0$	—	—	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V},$ $I_C=0$	—	—	-0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-100\mu\text{A}$	-50	—	—	V
Collector Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-1.0\text{mA}$	-50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-100\mu\text{A}$	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}	$V_{CE}=-6\text{V},$ $I_C=-2\text{mA}$	70	—	400	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-100\text{mA},$ $I_B=-10\text{mA}$	—	—	-0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-100\text{mA},$ $I_B=-10\text{mA}$	—	—	-1.0	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{CE}=-5.0\text{V},$ $I_C=-10\text{mA}$	—	—	-0.82	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=-5.0\text{V},$ $I_C=-10\text{mA}$	100	180	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V},$ $I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	4.0	7.0	pF